

PLANNING SALLE BLANCHE 2ème SEMESTRE 2011-2012

mâj le 5 avril 2012

MARS					AVRIL					MAI				
DATE	FORMATION	TP	SEANCES	Gr	DATE	FORMATION	TP	SEANCES	Gr	DATE	FORMATION	TP	SEANCES	Gr
1 J	M nano@school				1 D	M				1 M	M			fête du
	AM nano@school					AM				AM				travail
2 V	M PHELMA SMPB 2A	CAPA-DIODE	S1:nett+dryox+impl+rec+litho+gravure	5+6	2 L	M MIDEP 2011	MOSTEC	S1: nettoyage +dryox	1+2	2 M	M M. NANOTECH	MEMS	S3: implant+nett+recuit	3+4
	AM PHELMA SMPB 2A	CAPA-DIODE	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	5+6		AM MIDEP 2011	MOSTEC	S2: photolithographie Six + RIE	1+2	AM	M M. NANOTECH	MEMS	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	3+4
3 S	M				3 M	M PHELMA SEI	MOSTEC	S3: implant+nett+recuit	7+8	3 J	M nano@school			
	AM					AM PHELMA SEI	MOSTEC	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	7+8	AM	M nano@school			
4 D	M				4 M	M M. NANOTECH	MEMS	S1: photolithographe Si poly	1+2	4 V	M			
	AM					AM MIDEP 2011	MOSTEC	S3: implant+nett+recuit	1+2	AM				
						M M. NANOTECH	MEMS	S2: implantation + recuit	1+2					
						AM MIDEP 2011	MOSTEC	S4: dépôt+ photolithograp Al	1+2					
5 L	M nano@school				5 J	M nano@school				5 S	M			
	AM nano@school					AM nano@school				AM				
6 M	M PHELMA SEI	MOSTEC	S3: implant+nett+recuit	3+4	6 V	M PHELMA SIM	MOSTEC	S3: implant+nett+recuit	1	6 D	M			
	AM PHELMA SEI	MOSTEC	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	3+4		AM PHELMA SIM	MOSTEC	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	1	AM				
7 M	M High Tech U	litho	de 10h15 à 11h15 et de 11h30 à 12h30	1+2+3 4+5+6	7 S	M				7 L	M			
	AM High Tech U	litho	de 14h15 à 15h15 et de 16h à 17h	7+8+9 10+11+12		AM				AM				
8 J	M IUT MEPHY MCPC	CAPA	S1: nett + DRYox	1+2	8 D	M				8 M	M			armistice
	AM IUT MEPHY MCPC	CAPA	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	1+2		AM				AM				
9 V	M PHELMA SMPB 2A	CAPA-DIODE	S1:nett+dryox+impl+rec+litho+gravure	7+8	9 L	M		lundi		9 M	M FC	mostec	S1: nettoyage +dryox	1+2
	AM PHELMA SMPB 2A	CAPA-DIODE	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	7+8		AM		de Pâques		AM	M FC	mostec	S2: photolithographie Six + RIE	1+2
10 S	M				10 M	M				10 J	M FC	mostec	S3: implant+nett+recuit	1+2
	AM					AM				AM	M FC	mostec	S4: LTO + photolitho Ouv.CONT + pulvé	1+2
11 D	M				11 M	M				11 V	M FC	mostec	S5: dépôt + photolitho +gravure Al	1+2
	AM					AM				AM	M nano@school		formation profs nano@school	
12 L	M ENSGI	CAPADIODE	S1:nett+dryox+impl+rec+litho+gravure	1+2	12 J	M				12 S	M			
	AM ENSGI	CAPA-DIODE	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	1+2		AM				AM				
13 M	M PHELMA SEI	MOSTEC	S1: nettoyage +dryox	5+6	13 V	M				13 D	M			
	AM PHELMA SEI	MOSTEC	S2: photolithographie Six + RIE	5+6		AM				AM				
14 M	M <b>ESSAIS</b>	<b>TESTS</b>	<b>TRAPPES DESENFUMAGE</b>		14 S	M				14 L	M			
	AM <b>FORMATION</b>	<b>TP PV</b>	<b>EMILIE</b>			AM				AM				
15 J	M IUT MEPHY MCPC	CAPA	S1: nett + DRYox	3+4	15 D	M				15 M	M nano@school			
	AM IUT MEPHY MCPC	CAPA	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	3+4		AM				AM	M nano@school			
16 V	M <b>arrêt CTA</b>		<b>CEGELEC</b>		16 L	M Lpro IUT Chimie	biopuce	S1: LithoOX+etchKOH+nett+wetox	1+2	16 M	M iut MePhy alter	CAPA	S1: nett + DRYox	3+4
	AM <b>ESSAIS</b>		<b>SIRENES</b>			AM Lpro IUT Chimie	biopuce	S2: hydroxylation	1+2	AM	M iut MePhy alter	CAPA	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	3+4
17 S	M				17 M	M PHELMA SIM	PV	S1: litho+gravure ox+textu+diffPh	2+3	17 J	M			ascension
	AM					AM PHELMA SIM	PV	S2: désiox, nettoyage, dépôt Al	2+2	AM				
18 D	M				18 M	M M. NANOTECH	MEMS	S3: implant+nett+recuit	1+2	18 V	M			
	AM					AM M. NANOTECH	MEMS	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	1+2	AM				
19 L	M ENSGI	CAPA-DIODE	S1:nett+dryox+impl+rec+litho+gravure	3+4	19 J	M Lpro IUT Chimie	CAPA	S1: nett + DRYox	1+2	19 S	M			
	AM ENSGI	CAPA-DIODE	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	3+4		AM Lpro IUT Chimie	CAPA	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	1+2	AM				
20 M	M PHELMA SEI	MOSTEC	S3: implant+nett+recuit	5+6	20 V	M PHELMA SIM	PV	s3: RTA, dépôt SiN, photolitho	2+3	20 D	M			
	AM PHELMA SEI	MOSTEC	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	5+6		AM PHELMA SIM	PV	s4: BOE, dépôt alu, lift off	2+3	AM				
21 M	M M. NANOTECH	MEMS	S1: photolithographe Si poly	5+6	21 S	M				21 L	M nano@school			
	AM M. NANOTECH	MEMS	S2: implantation + recuit	5+6		AM				AM	M nano@school			
22 J	M IUT MEPHY MCPC	CAPA	S1: nett + DRYox	5+6	22 D	M				22 M	M			
	AM IUT MEPHY MCPC	CAPA	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	5+6		AM				AM				
23 V	M nano@school		formation profs nano@school	1+2	23 L	M Lpro IUT Chimie	biopuce	S1: photolithoOX+etchKOH+nett+wetox	3+4	23 M	M POLYTECH NICE	chapron	S1: ouvertures ZA + implantation	3+4
	AM					AM Lpro IUT Chimie	biopuce	S2: hydroxylation	3+4	AM	M POLYTECH NICE	chapron	S2 : photolitho+grav. Ox. + dryOx	3+4
24 S	M				24 M	M				24 J	M POLYTECH NICE	chapron	S3 : ouverture des contacts	3+4
	AM					AM				AM	M POLYTECH NICE	chapron	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	3+4
25 D	M				25 M	M M. NANOTECH	MEMS	S1: photolithographe Si poly	3+4	25 V	M			
	AM					AM M. NANOTECH	MEMS	S2: implantation + recuit	3+4	AM				
26 L	M nano@school		8 élèves		26 J	M Lpro IUT Chimie	CAPA	S1: nett + DRYox	3+4	26 S	M			
	AM nano@school		8 élèves			AM Lpro IUT Chimie	CAPA	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	3+4	AM				
27 M	M PHELMA SEI	MOSTEC	S1: nettoyage +dryox	7+8	27 V	M nano@school				27 D	M			
	AM PHELMA SEI	MOSTEC	S2: photolithographie Six + RIE	7+8		AM nano@school				AM				
28 M	M M. NANOTECH	MEMS	S3: implant+nett+recuit	5+6	28 S	M				28 L	M MASTER EEAP	mostec	S1: nettoyage +dryox	1
	AM M. NANOTECH	MEMS	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	5+6		AM				AM	M MASTER EEAP	mostec	S2: photolithographie Six + RIE	1
29 J	M High Tech U	litho	de 10h15 à 11h15 et de 11h30 à 12h30	13+14+15 16+17+18 19+20+21 22+23+24	29 D	M				29 M	M MASTER EEAP	mostec	S3: implant+nett+recuit	1
	AM High Tech U	litho	de 14h15 à 15h15 et de 16h à 17h			AM				AM	M MASTER EEAP	mostec	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	1
30 V	M PHELMA SIM	MOSTEC	S1: nettoyage +dryox	1	30 L	M				30 M	M iut MePhy alter	CAPA	S1: nett + DRYox	5+6
	AM PHELMA SIM	MOSTEC	S2: photolithographie Six + RIE	1		AM				AM	M iut MePhy alter	CAPA	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	5+6
31 S	M				31 J	M				31 AM	M nano@school			
	AM					AM					M nano@school			

PLANNING SALLE BLANCHE 2ème SEMESTRE 2011-2012

màj le 5 avril 2012

JUN						JUILLET						AOÛT					
DATE	FORMATION	TP	SEANCES	Gr		DATE	FORMATION	TP	SEANCES	Gr	DATE	FORMATION	TP	SEANCES	Gr		
1	V	M				1	D	M			1	M	M				
		AM						AM				AM					
2	S	M				2	L	M	FC	mostec	S1: nettoyage +dryox			3+4			
		AM						AM	FC	mostec	S2: photolithographie Six + RIE			3+4			
3	D	M				3	M	M	FC	mostec	S3: implant+nett+recuit			3+4			
								AM	FC	mostec	S4: LTO + photolith Ouv.CONT + pulvé			3+4			
4	L	M				4	M	M	FC	mostec	S5: dépôt + photolitho +gravure Al			3+4			
								AM									
5	M		High Tech U	litho	de 10h15 à 11h15 et de 11h30 à 12h30	25+26+27 28+29+30	5	J	M								
			High Tech U	litho	de 14h15 à 15h15 et de 16h à 17h	31+32+33 34+35+36			AM								
6	M		SUMMER PRGM				6	V	M								
			SUMMER PRGM					AM									
7	J	M	SUMMER PRGM				7	S	M								
			SUMMER PRGM					AM									
8	V	M					8	D	M								
								AM									
9	S	M					9	L	M		EURODOT						
								AM									
10	D	M					10	M	M								
								AM									
11	L	M	classe découverte ingé		litho + visite		11	M	M		EURODOT						
			classe découverte ingé		litho + visite			AM									
12	M	M	FC init à la jelec	capa-diode	S1:nett+dryox+impl+rec+litho+gravure	2 gpes	12	J	M								
			FC init à la jelec	capa-diode	S2: dépôt + photolitho +gravure alu	2 gpes		AM									
13	M		SUMMER PRGM	TP PV			13	V	M								
			SUMMER PRGM	TP PV				AM			EURODOT						
14	J	M	SUMMER PRGM	TP PV			14	S	M								
			SUMMER PRGM	TP PV				AM									
15	V	M					15	D	M								
								AM									
16	S	M					16	L	M								
								AM									
17	D	M					17	M	M								
								AM									
18	L	M					18	M	M								
								AM									
19	M	M					19	J	M								
								AM									
20	M		SUMMER PRGM	TP PV			20	V	M								
			SUMMER PRGM	TP PV				AM									
21	J	M	SUMMER PRGM	TP PV			21	S	M								
			SUMMER PRGM	TP PV				AM									
22	V	M					22	D	M								
								AM									
23	S	M					23	L	M								
								AM									
24	D	M					24	M	M								
								AM									
25	L	M					25	M	M								
								AM									
26	M	M					26	J	M								
								AM									
27	M	M	MASTER EEAP	MEMS	S1: photolithographe Si poly	2	27	V	M								
			MASTER EEAP	MEMS	S2: implantation + recuit	2		AM									
28	J	M	MASTER EEAP	MEMS	S3: implant+nett+recuit	2	28	S	M								
			MASTER EEAP	MEMS	S4: dépôt + photolitho +gravure Al	2		AM									
29	V	M					29	D	M								
								AM									
30	S	M					30	L	M			ESONN	jope				
								AM				ESONN	jope				
							31	M	M			ESONN	JOPE MEMS				
								AM				ESONN	JOPE MEMS				